



Транзистор 2Т716А1

ОКП 63 4120

ЭТИКЕТКА

ЮФ3.365.127-03 ЭТ

Кремниевые меза-планарные мощные высоковольтные составные p-n-p транзисторы 2Т716А1, 2Т716Б1, 2Т716В1 в пластмассовом корпусе КТ-28-2 ГОСТ 18472-88, предназначенные для работы в ключевых и линейных схемах аппаратуры специального назначения групп исполнения 1.1, 1.2, 1.5.1, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.4, 1.7.1, 1.8.1, 2.1.1, 2.2.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98 с индивидуальной защитой или общей герметизацией.

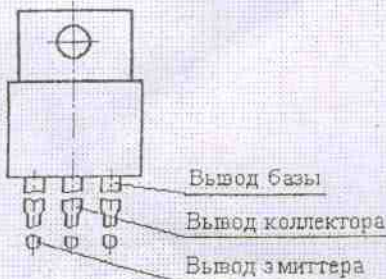
Код даты изготовления транзисторов по ГОСТ 30668-2000.

Сертификат ЦОС "Военэлектронсерт"

Филиал ФБУ "46 ЦНИИ Минобороны России"

№ СВС.01.431.0337.11

Схема расположения выводов



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры при $t_{\text{окр}} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения,	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока, ($U_{\text{кб}} = 5 \text{ В}$, $I_{\text{э}} = 5 \text{ А}$) 2Т716А1 2Т716Б1, 2Т716В1	$h_{21Э}$	500 750	
Обратный ток коллектора, мА ($U_{\text{кб}} = 100 \text{ В}$) 2Т716А1 ($U_{\text{кб}} = 80 \text{ В}$) 2Т716Б1 ($U_{\text{кб}} = 60 \text{ В}$) 2Т716В1	$I_{\text{кб0}}$		1 1 1
Граничное напряжение, ($I_{\text{к}} = 100 \text{ мА}$, $\tau_{\text{и}} = 300 \text{ мкс} \pm 10\%$, $Q \geq 100$, $\Delta t_{\text{гсм}} = 160 \text{ мкс}$, $U_{\text{кэ отр}} = 110 - 120 \text{ В}$), В 2Т716А1 2Т716Б1 2Т716В1	$U_{\text{кэ0 гр}}$	80 60 40	
Пробивное напряжение коллектор-база, ($I_{\text{к}} = 1 \text{ мА}$), В 2Т716А1 2Т716Б1 2Т716В1	$U_{\text{кб0 проб}}$	100 80 60	
Пробивное напряжение эмиттер-база, ($I_{\text{э}} = 5 \text{ мА}$), В	$U_{\text{эб0 проб}}$	5	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, ($I_{\text{к}} = 5 \text{ А}$, $I_{\text{э}} = 0,02 \text{ А}$), В	$U_{\text{кэ нас}}$		2
Напряжение насыщения база-эмиттер, ($I_{\text{к}} = 5 \text{ А}$, $I_{\text{э}} = 0,02 \text{ А}$), В	$U_{\text{кэ нас}}$		3

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт.

транзисторов:

золото 0,0233 г

серебро 0,255 г

1.3 Содержание цветных металлов:

медь – 1,53 г в одном транзисторе.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 25000 ч, а в облегченном режиме при мощности 0,5, токах и напряжениях не более 0,7 максимально допустимых значений, $t_{\text{корп}} \leq 25^\circ\text{C}$ – 50000 ч.

2.2 Гамма-процентный ресурс при $\gamma = 95\%$ в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 50000 ч, а в облегченном режиме – 80000 ч.

2.3 Минимальный срок сохраняемости транзисторов при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или во всех местах хранения транзисторов, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, 25 лет.

При хранении транзисторов в упаковке изготовителя или смонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом, а также на открытой площадке минимальный срок сохраняемости соответствует ГОСТ В 28146-89.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных транзисторов требованиям аА0.339.628 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и технических условиях на транзисторы.

Гарантийный срок – 25 лет с даты изготовления, а в случае перепроверки транзисторов – с даты перепроверки. Гарантийная наработка:

25000 ч – в режимах и условиях, допускаемых ТУ;
50000 ч – в облегченном режиме.

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов 2Т716А1, 2Т716Б1, 2Т716В1 соответствуют техническим условиям аА0.339.628 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 7 от 30.05.13 дата

Место для штамп ССК ОТК 100 12 Место для штамп ВП 8

Место для штампа "Перепроверка произведена" _____ дата

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Место для штамп ССК _____ Место для штамп ВП _____

Цена договорная